

# 2SK776



20S2A

NチャネルMOS形  
シリコン電界効果トランジスタ

## 超高速スイッチング用

©2060

特長 ・低オン抵抗, 超高速スイッチング。

### 絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings/Ta=25°C

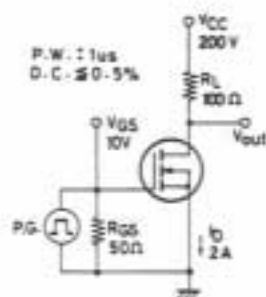
			unit
ドレイン-ソース電圧	V <sub>DS</sub>	450	V
ゲート-ソース電圧	V <sub>GS</sub>	±20	V
ドレイン電流(D.C.)	I <sub>D</sub>	5	A
ドレイン電流(Pulse)	I <sub>D peak</sub>	10	A
許容損失	P <sub>D</sub>	60	W
接合部温度	T <sub>J</sub>	150	°C
保存周囲温度	T <sub>stg</sub>	-55~+150	°C

T<sub>c</sub>=25°C

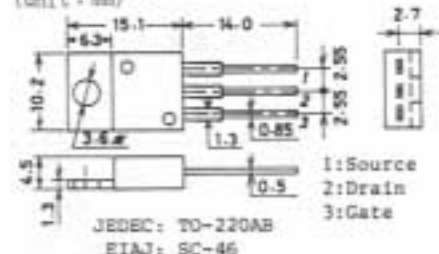
### 電気的特性 Electrical Characteristics/Ta=25°C

			min	typ	max	unit
ドレイン-ソース降伏電圧	V <sub>DS</sub>	I <sub>D</sub> =1mA, V <sub>GS</sub> =0	450			V
ドレイン-ソースしゅ断電流	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> =450V, V <sub>GS</sub> =0			1.0	mA
ゲート-ソースもれ電流	I <sub>GSS</sub>	V <sub>GS</sub> =±20V, V <sub>DS</sub> =0			±100	nA
ゲート-ソースしゅ断電圧	V <sub>GS(off)</sub>	V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =1mA	1.5		4.0	V
順伝達遅延時間	t <sub>YFS1</sub>	V <sub>DS</sub> =10V, I <sub>D</sub> =2A	1.2	2.5		s
飽和抵抗	R <sub>DS(on)</sub>	I <sub>D</sub> =2A, V <sub>GS</sub> =10V		1.2	1.6	Ω
入力容量	C <sub>iss</sub>	V <sub>DS</sub> =20V, f=1MHz		800		pF
出力容量	C <sub>oss</sub>	V <sub>DS</sub> =20V, f=1MHz		100		pF
帰還容量	C <sub>rss</sub>	V <sub>DS</sub> =20V, f=1MHz		20		pF
ターンオン遅延時間	t <sub>d(on)</sub>	I <sub>D</sub> =2A, V <sub>GS</sub> =10V V <sub>CC</sub> =200V, R <sub>GS</sub> =50Ω		20	40	ns
立ち上がり時間	t <sub>r</sub>			20	40	ns
ターンオフ遅延時間	t <sub>d(off)</sub>			100	200	ns
下降時間	t <sub>f</sub>			50	100	ns

### スイッチングタイム測定回路



外形図 20S2A  
(unit: mm)



注: ゲート-ソース間には保護ダイオードは入っていないため 取扱いに十分注意すること。